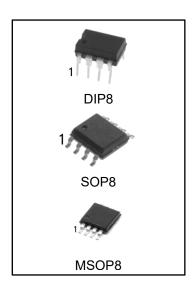


特点

- 低静态工作电流;
- 宽电源电压范围: 2.5V-12V;
- 每通道具有 800mA 连续电流输出能力;
- 较低的饱和压降;
- 输出具有正转、反转、高阻和刹车四种状态;
- TTL/CMOS 输出电平兼容,可直接连 CPU;
- 输出内置钳位二极管,适用于感性负载;
- 控制和驱动集成于单片 IC 之中;
- 具备管脚高压保护功能;
- 工作温度: -20℃-80℃。



产品订购信息

产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
L9110PG	DIP8	L9110	管装	2000 只/盒
L9110DRG	SOP8	L9110	编带	2500 只/盘
L9110DGKRG	MSOP8	L9110	编带	3000 只/盘

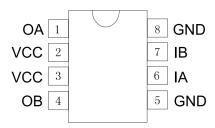


描述

L9110 是为控制和驱动电机设计的两通道推挽式功率放大专用集成电路器件,将分立电路 集成 在 单 片 IC 之 中,使外 围 器件 成 本 降 低,整 机可 靠 性 提 高。该芯 片有两个 TTL/CMOS 兼容电平的输入,具有良好的抗干扰性;两个输出端能直接驱动电机的正反向运动及刹车,它具有较大的电流驱动能力,每通道能通过 750~800mA 的持续电流,峰值电流能力可达 1.5~2.0A;同时它具有较低的输出饱和压降;内置的钳位二极管能释放感性负载的反向冲击电流,使它在驱动继电器、直流电机、步进电机或开关功率管的使用上安全可靠。L9110 被广泛应用于保险柜、玩具汽车的电机驱动、步进电机驱动和开关功率管等电路上。

引出端排列

引出端排列按下图的规定。引出端排列为俯视图。



序号	符号	功能	序号	符号	功能
1	OA	A 路输出管脚	5	GND	地线
2	VCC	电源电压	6	IA	A 路输入管脚
3	VCC	电源电压	7	IB	B 路输入管脚
4	ОВ	B 路输出管脚	8	GND	地线



极限值

<i> </i>	← ¥4	范 ***			
符号	参数	最 小	典型	最大	单 位
VCC	电源电压	2.2	6	12	V
I _{Max}	电流峰值	电流峰值 -		2000	mA
VH _{IN}	输入高电平	2.5	5.0	12	V
VL _{IN}	输入低电平	0	0.5	0.7	V
Pd max	允许电源消耗	-	-	800	mW
Topr	操作温度	-40	25	85	$^{\circ}$

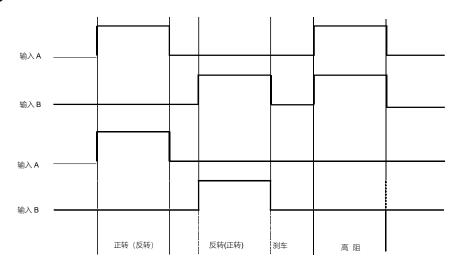
电特性 (VCC=5V, Ta=25℃)

<i>b</i> /c ==	<i>↔ ₩</i> ₽		24 (->-		
符号	参数	最小	典型	最大	单位
IDD	静态电流	=	0.1	2.0	uA
IIN	操作电流	-	100	200	uA
VO(sat1)	输出饱和压降 Iout=500mA	-	1.00	1.15	V
VO(sat1)	输出饱和压降 I _{out} =200mA	-	0.75	0.85	V
IOUT	持续输出电流	750	800	850	mA
I _{Max}	电流峰值	-	1500	2000	mA

逻辑功能真值表

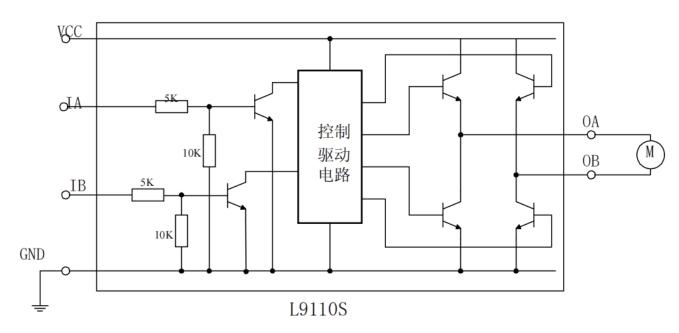
IA	IB	OA	ОВ
Н	L	Н	L
L	Н	L	Н
L	L	L (刹车)	L (刹车)
Н	Н	Z (高阻)	Z (高阻)

引出端波形

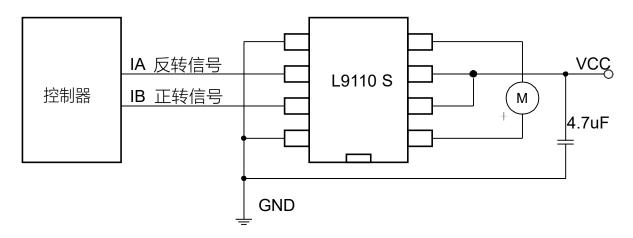




电路内部功能框图



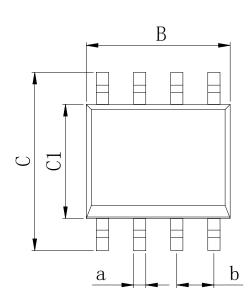
应用电路图

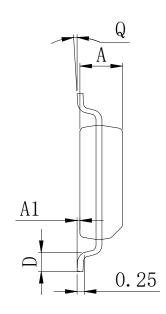




封装外型尺寸

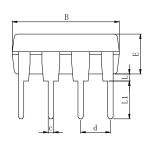
SOP8

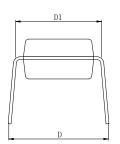


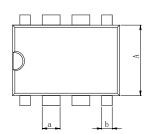


Dimensions In Millimeters(SOP8)										
Symbol:	Α	A1	В	С	C1	D	Q	а	b	
Min:	1.35	0.05	4.90	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	1.27 BSC	
Max:	1.55	0.20	5.10	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	1.27 630	

DIP8





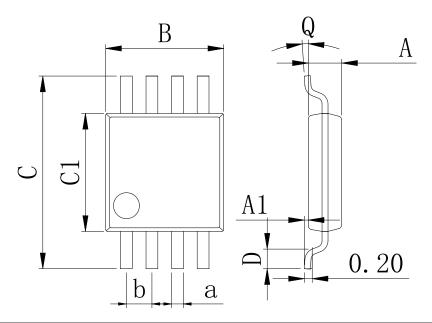


Dimensions In Millimeters(DIP8)											
Symbol:	Α	В	D	D1	Е	L	L1	а	b	С	d
Min:	6.10	9.00	8.40	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.85	0.40	2.54 BSC
Max:	6.68	9.50	9.00	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.90	0.50	2.04 BSC



封装外型尺寸

MSOP8



Dimensions In Millimeters(MSOP8)										
Symbol:	Α	A1	В	С	C1	D	Q	а	b	
Min:	0.80	0.05	2.90	4.75	2.90	0.35	0°	0.25	0.65 BSC	
Max:	0.90	0.20	3.10	5.05	3.10	0.75	8°	0.35	0.00 BSC	



重要声明:

汉芯半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。汉芯半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。

客户在使用汉芯半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任: 针对您的应用选择合适的汉芯半导体产品; 设计、验证并测试您的应用;确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

汉芯半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,汉芯半导体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。

汉芯半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,测试和其他质量控制技术的使用只限于汉芯半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。

汉芯半导体的文档资料,授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他汉芯半导体知识产权或任何第三方知识产权。严禁对这些资源进行其他复制或展示,您应全额赔偿因在这些资源的使用中对汉芯半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,汉芯半导体对此概不负责。